

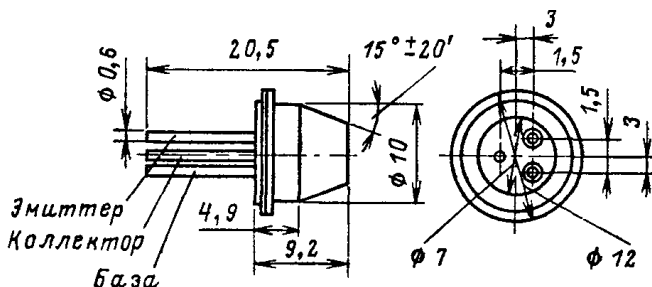
1Т403А, 1Т403Б, 1Т403В, 1Т403Г, 1Т403Д, 1Т403Е, 1Т403Ж, 1Т403И, ГТ403А, ГТ403Б, ГТ403В, ГТ403Г, ГТ403Д, ГТ403Е, ГТ403Ж, ГТ403И, ГТ403Ю

Транзисторы германиевые сплавные *p-n-p* усилительные низко-
частотные маломощные.

Предназначены для работы в схемах переключения, выходных
каскадах усилителей низкой частоты, преобразователях и стабили-
заторах постоянного тока.

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами.
Обозначение типа приводится на корпусе

Масса транзистора не более 4 г.



Электрические параметры

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_K = 0,5$ А, $I_B = 0,05$ А не более	0,5 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_K = 0,5$ А, $I_B = 0,05$ А не более	0,8 В
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при $U_{КБ} = 5$ В, $I_Э = 0,1$ А, $f = 50 \div 300$ Гц:	
1Т403А, 1Т403В, 1Т403Ж, ГТ403А, ГТ403В, ГТ403Ж	20–60
1Т403Б, 1Т403Г, 1Т403Д, ГТ403Б, ГТ403Г, ГТ403Д	50–150
ГТ403Ю	30–60
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КБ} = 1$ В, $I_Э = 0,45$ А 1Т403Е, ГТ403Е, 1Т403И, ГТ403И не менее	30
Изменение коэффициента передачи тока в режиме малого сигнала 1Т403А, 1Т403Б, 1Т403В, 1Т403Г, 1Т403Д, 1Т403Ж при $U_{КБ} = 5$ В, $I_Э = 0,1$ А, $f = 50 \div 300$ Гц не более:	
при $T = 343$ К	$\pm 30\%$
при $T = 213$ К	-50%

Материал взят из источника:

Изменение статического коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером 1Т403Е, 1Т403И при $U_{КБ} = 1$ В, $I_{Э} = 0,45$ А не более	
при $T = 343$ К	$\pm 30\%$
при $T = 213$ К	$+50\%$ -40%
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КБ} = 5$ В, $I_{Э} = 0,1$ А не менее	
	8 кГц
Плавающее напряжение эмиттер-база при $U_{КБ} = 45$ В 1Т403А, 1Т403Б, при $U_{КБ} = 60$ В 1Т403В, 1Т403Г, 1Т403Д, 1Т403Е, при $U_{КБ} = 80$ В 1Т403Ж, 1Т403И при $T = 343$ К не более	
	0,3 В
Обратный ток коллектора при $U_{КБ} = U_{КБ \text{ макс}}$ не более при $T = 298$ К	
1Т403А, 1Т403Б, 1Т403В, 1Т403Г, 1Т403Д, 1Т403Е, ГТ403А, ГТ403Б, ГТ403В, ГТ403Г, ГТ403Д, ГТ403Е, ГТ403Ю	50 мкА
1Т403Ж, 1Т403И, ГТ403Ж, ГТ403И	70 мкА
при $T = 343$ К	800 мкА
Обратный ток эмиттера при $U_{БЭ} = 20$ В 1Т403А, 1Т403Б, 1Т403В, 1Т403Г, 1Т403Е, ГТ403А, ГТ403Б, ГТ403В, ГТ403Г, ГТ403Е, ГТ403Ю, $U_{БЭ} = 30$ В 1Т403Д, ГТ403Д не более при $T = 298$ К	
1Т403А, 1Т403Б, 1Т403В, 1Т403Г, 1Т403Д, 1Т403Е, ГТ403А, ГТ403Б, ГТ403В, ГТ403Г, ГТ403Д, ГТ403Е, ГТ403Ю	50 мкА
1Т403Ж, 1Т403И, ГТ403Ж, ГТ403И	70 мкА
при $T = 343$ К	800 мкА
Обратный ток коллектор-эмиттер при $U_{КЭ} = U_{КЭ \text{ макс}}$ 1Т403А, 1Т403Б, 1Т403В, 1Т403Г, 1Т403Д, 1Т403Е, ГТ403А, ГТ403Б, ГТ403В, ГТ403Г, ГТ403Д, ГТ403Е, ГТ403Ю	
	5 мА
1Т403Ж, 1Т403И, ГТ403Ж, ГТ403И	6 мА

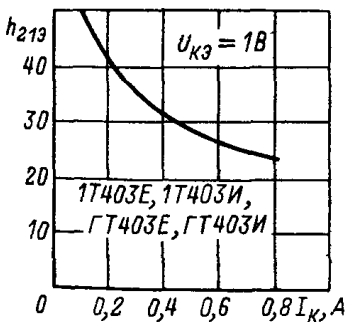
Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер	
1Т403А, 1Т403Б, ГТ403А, ГТ403Б, ГТ403Ю	30 В
1Т403В, 1Т403Е, ГТ403В, ГТ403Е, 1Т403Г, 1Т403Д, ГТ403Г, ГТ403Д	45 В
1Т403Ж, 1Т403И, ГТ403Ж, ГТ403И	60 В
Постоянное напряжение коллектор-база	
1Т403А, 1Т403Б, ГТ403А, ГТ403Б, ГТ403Ю	45 В
1Т403В, 1Т403Е, 1Т403Г, 1Т403Д, ГТ403В, ГТ403Е, ГТ403Г, ГТ403Д	60 В
1Т403Ж, 1Т403И, ГТ403Ж, ГТ403И	80 В

Материал взят из источника:

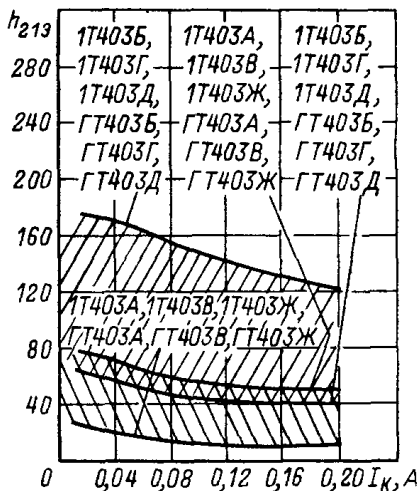
Постоянное напряжение эмиттер-база	20 В
1Т403Д, ГТ403Д	30 В
Постоянный ток коллектора	1,25 А
Постоянный ток базы	0,4 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора	
с теплоотводом	$(358 - T_K) / R_{T \text{ п-к}}$, Вт
без теплоотвода	$(358 - T) / R_{T \text{ п-с}}$, Вт
Тепловое сопротивление переход-корпус	15 К/Вт
1Т403В, 1Т403Е, ГТ403В, ГТ403Е	12 К/Вт
Тепловое сопротивление переход-среда	100 К/Вт
Температура перехода	358 К
Температура окружающей среды	
1Т403	От 213 до 343 К
ГТ403	От 218 до 343 К

Примечание Разрешается производить изгиб и пайку выводов на расстоянии не менее 3 мм от корпуса транзистора с температурой жала паяльника не более 533 К в течение 3 с и групповым или механизированным способом при температуре припоя не более 533 К в течение 5 с

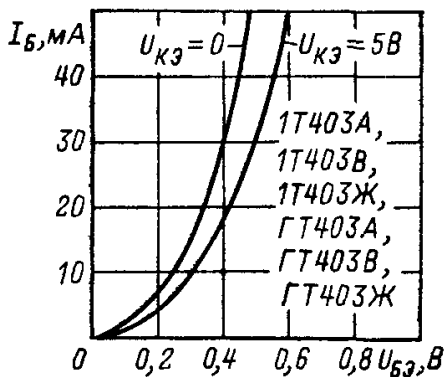


Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока коллектора

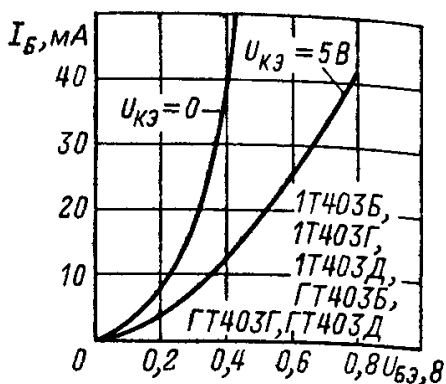
Зона возможных положений зависимости статического коэффициента тока от тока коллектора.



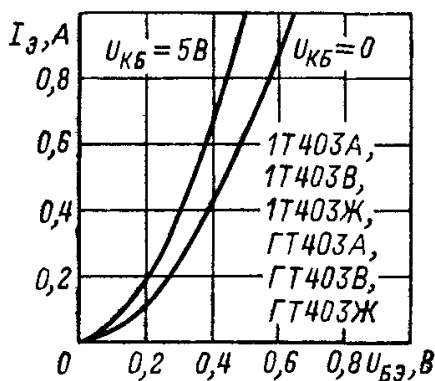
Материал взят из источника:



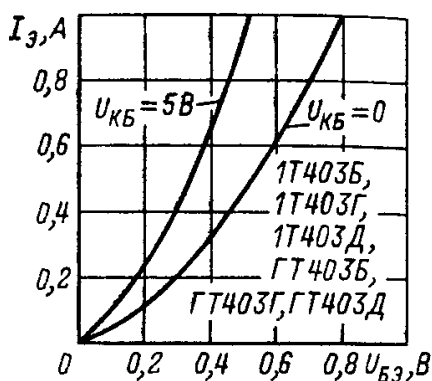
Входные характеристики



Входные характеристики



Зависимость тока эмиттера от напряжения база-эмиттер



Зависимость тока эмиттера от напряжения база-эмиттер

Материал взят из источника:

Полупроводниковые приборы: Транзисторы. Горюнов Н. Н. (ред)
 Энергоатомиздат, 1985

